

2SB551H

シリコン PNP 三重拡散形

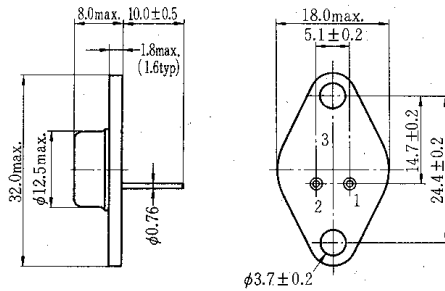
低周波電力増幅用

2SC830 $\text{\textcircled{H}}$ とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SC830 $\text{\textcircled{H}}$



(JEDEC TO-66)

1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SB551 $\text{\textcircled{H}}$	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CBO}	-50	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	-4	V
コレクタ電流		I_C	-3	A
許容コレクタ損失		P_C^*	25	W
接合部温度		T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

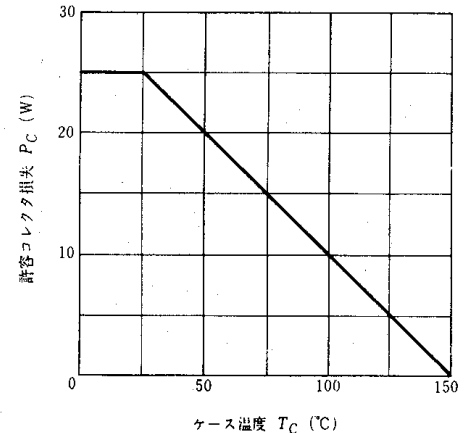
項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-5\text{mA}, I_E=0$	-50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-5\text{mA}, I_C=0$	-4	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=-20\text{V}, I_E=0$	—	—	-100	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=-4\text{V}$	$I_C=-1\text{A}$	35	—	200	
	h_{FE2}		$I_C=-0.1\text{A}$	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-1\text{A}$	—	-0.95	-1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2\text{A}, I_B=-0.2\text{A}$	—	—	-1.2	V
利得帯域幅積		f_T	$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-0.5\text{A}$	15	32	—	MHz
2次破壊電流		I_M	$V_{CE}=-40\text{V}, f=50\text{Hz}$ (Half Wave)	-2.0	-4.5	—	A

* 2SB551 $\text{\textcircled{H}}$ は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

* The 2SB551 $\text{\textcircled{H}}$ is grouped by h_{FE1} as follows.

①	②	③
35~70	60~120	100~200

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



安全動作領域 AREA OF SAFE OPERATION

